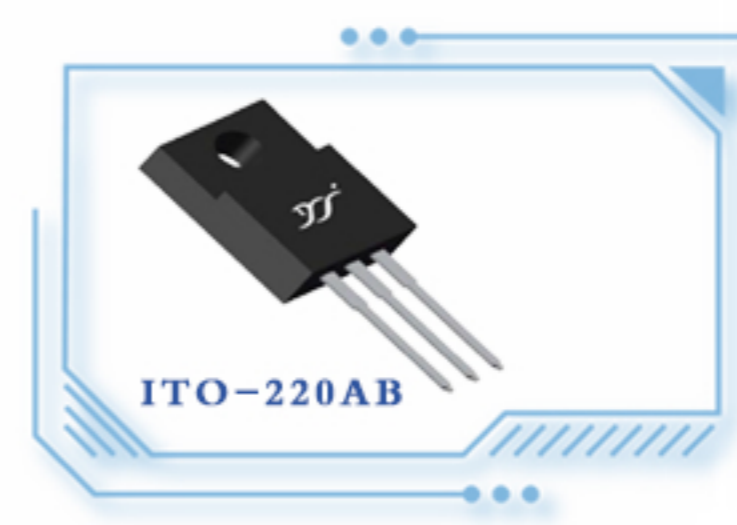


650V Super Junction N-Channel MOSFET

产品介绍

1.采用扬杰科技特殊多层外延工艺制程设计的650V系列超结产品，可以满足低导通损耗、低开关损耗、EMI兼容性以及不同电路拓扑结构应用要求，产品具有良好的导通内阻 (R_{dson})和栅极电荷 (Q_g)性能，降低导通损耗和开关损耗，更低的开关噪声、更低的 T_{rr} ，综合提升系统稳定性及性能。

2.开关速度与EMI平衡、更低的 T_{rr} 特点，适用于充电器，电源适配器，TV电源、工业电源等领域，亦可满足一些半桥或各种桥式电路拓扑结构应用要求。



产品特点

1.采用扬杰科技特殊多层外延工艺制程设计，具有更高的工艺稳定性和可靠性，开关速度与EMI平衡、更低的 T_{rr} 特点；

2.系列产品具有低导通电阻、低栅极电荷、导通损耗和开关损耗低的特点；

3.采用TO-252/ITO-220AB封装，具有更好的热值特性。

电性参数

PART NO	Package	V_{DSS} (V)	I_D (A)	V_{GS} (V)	V_{th} (V)			$R_{dson}(m\Omega)$ @ $V_{GS}10V$		C_{iss} (pF)	C_{oss} (pF)	C_{rss} (pF)	Q_g (nC)
					Min	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Typ	Typ	Typ
YJD12C65H	TO-252	650	12	± 30	2.5	3.8	5	280	380	1020	30	4	25
YJF12C65H	ITO-220AB	650	12	± 30	2.5	3.8	5	280	380	1050	30	3	25

更多产品详见官网

应用领域

❖ LCD TV / 显示器电源

❖ PC电源 / 工业电源

通信 / 服务器电源

照明 / 充电器 / 电源适配器

